STM mérések molekulákon

Balogh Zoltán Nanofizika szeminárium 2012.03.01.



<u>Bevezető:</u>



Molekulák vizsgálata:

Ehhez elektródákat kell kapcsolnunk a molekulákra — > Hogyan?

Létre kell hoznunk egy kis méretű gap-et(korábbi előadás)

- MCBJ technika
- Elektromigráció
- Elektrokémiai depozíció
- Párologtatás
- stb.

Egy vagy több elektródás elrendezések is létrehozhatók.







Széles körben használt módszer, sok mérés
 szobahőmérsékleten, UHV-ban vagy alacsonyhőmérsékleten

Előnyei: - különböző elektróda anyagok

- nagy molekulával borított felületek vizsgálhatók



<u>Probléma:</u> a molekula és a vezető felület erősen csatolódhat, ez megváltoztatja a molekula tulajdonságait. Pl.: a szabad molekula két állapotú kapcsolható tulajdonságot mutat, a felületre kötődött viszont nem, illetve az energiaszintek is elhangolódhatnak.

Molekulák lecsatolása: néhány atomi rétegű szigetelő felületet elég növeszteni a substrate-ra

Szigetelők: NaCl, KBr, RbI

Néha viszont a szigetelő réteg csatolódik a molekulához



Tű szerepe STM mérésekben:



Az eredeti (tiszta) tű (Pt/Ir, Au, Cu, stb.) karakterisztikája molekulák "felvételével" megváltoztatható.

Kísérletekben használtak CO, H_2 és különböző szerves molekulákat (pentacene)

Ezzel a módszerrel nagyobb felbontású STM mérések érhetők el, valamint a fentieknek megfelelően a tű karakterisztikájának megváltozása új információkat eredményezhet

A nagyobb felbontás a minta és a tű végének (ez esetben a molekula) effektív távolságának csökkenésének köszönhető.



Ś

High-Resolution Molecular Orbital Imaging Using a *p*-Wave STM Tip

Leo Gross,^{1,*} Nikolaj Moll,¹ Fabian Mohn,¹ Alessandro Curioni,¹ Gerhard Meyer,¹ Felix Hanke,² and Mats Persson² ¹IBM Research—Zurich, 8803 Rüschlikon, Switzerland

²Surface Science Research Centre, Department of Chemistry, University of Liverpool, Liverpool, L69 3BX, United Kingdom (Received 3 June 2011; published 15 August 2011)

Pentacene és Naphthalocyanine molekulák mérése CU(111) substrate-on, NaCl szigetelő





Nagy felbontás: tű anyagának módosítása

PtIr tű — PtIr tű – PtIr t



CO molekula felvétele a tűvel

p-hullámú



A mérés és a számolás kvalitatíve visszaadja a molekula szerkezetét

A pentacene molekulánál a p-hullámű tű nem ad jelentős plusz információt, a molekula felbontható s-hullámú tűvel is

Naphthalocyanine molekula

A csomópontok közelebb helyezkednek el, így ezt már nem lehet felbontani s típusú tűvel

A p-hullámú tű plusz információt szolgáltat, viszont nem mutat jó egyezést a kísérleti és a számolt kép

A korábbi módon kevert típusú tűvel készített számolás viszont nagyon jó egyezést mutat a konstans magasságú kísérleti ábrával



Ezek az eredmények megmutatták, hogy az s és p típusú járulékok nem csak a tű típusától függenek

A relatív súlyuk változik, a p típus erős a nagy gradiensű, az s típus pedig a nagy abszolút értékű helyeken

Ezen kívül jelentős függés az aktuális környezettől (fázis)



A mérések megmutatták, hogy CO molekulával végződő STM tűvel bizonyos esetekben jelentős mennyiségű plusz információt nyerhetünk a mérendő molekuláról, így ez a módszer jól alkalmazható molekuláris elektronikai mérésekben

g

Reversible Bond Formation in a Gold-Atom–Organic-Molecule Complex as a Molecular Switch

Fabian Mohn,^{1,*} Jascha Repp,^{2,1} Leo Gross,¹ Gerhard Meyer,¹ Matthew S. Dyer,³ and Mats Persson^{3,4} ¹IBM Research–Zurich, 8803 Rüschlikon, Switzerland

²Institute of Experimental and Applied Physics, University of Regensburg, 93040 Regensburg, Germany
³Surface Science Research Centre, Department of Chemistry, University of Liverpool, Liverpool, L69 3BX, United Kingdom
⁴Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology, SE-412 96, Göteborg, Sweden (Received 16 September 2010; published 28 December 2010)

Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride (PTCDA) molekula Cu substrate-on 2 réteg NaCl szigetelővel

CO végződésű tű (preparáció ugyan az mint az előző méréseknél)

A PTCDA molekulából és egy Au atomból álló molekula-fém komplexen kapcsolható tulajdonságot mértek a kötött és nem-kötött állapotok között.



Szórási mintázatok:

PTCDA elektronaffinitása (4.6eV) nagyobb minta substrate kilépési munkája (3.9eV)

Az Au atom is egyszeres negatív töltést mutat

A kötött Au-PTCDA viszont egyszeres töltésű lesz

Töltés állapot váltás

I-V görbéken látható, hogy az alagútáram jelentős változást mutat

Az átkapcsolás megbízhatóan reverzibilis és több tíz ciklus alatt is csak kicsi (<0.1V) eltérés adódott a kapcsolási feszültségben.







megemelkedik

Ez az elrendezés egy rendkívül megbízható, jól működő molekuláris switch-et mutat be, ami egy kötött és egy nem kötött állapot közti átugrásnak tulajdonítható



Coherent electron-nuclear coupling in oligothiophene molecular wires

Jascha Repp^{1,2}*, Peter Liljeroth^{1,3} and Gerhard Meyer¹

Különböző hosszúságú oligothiophene molekulák vizsgálata Cu(111) substrate-on NaCl, Xe, RbI szigetelő rétegeken

Érdekes, az egyszerű modell alapján nem várt viselkedés

Elektron-vibron csatolás



Különböző hosszúságú molekulák



L + OMU1 LUMO LUMO+2 8 LUMO + 3 dl/dV (arb. units) 6 LUMO + 4 LUMO+5 4 2 0 1.5 2.0 2.5 3.0 Voltage (V)

In-gap és LUMO mérés

d LUMO







dI/dV görbék a molekula kül. pontjain b

Hosszú molekula 🛛 🕒 1D bezáró potenciállal modellezhető

Ezt mutatja a különböző molekula pályák térbeli alakja is



 $E(k) = E_0 + \sqrt{A^2 + B^2 k^2}$

Hiperbolikus függés a thiophene monomerek számától (molekula hossza)

Ez lineáris hullámszám függést jelent a hullámszám szerint

Mivel ez a linearitás az alacsony hullámszámoknál (nagy hosszak) is fenn áll, ellentmondás látszik a modell és a mérési eredmény között

Lehetséges magyarázat non-Born-Oppenheimer tartomány: az elektronok és a molekula rezgése nem csatolódik szét



Rövid molekulákra dI/dV spektrumban csúcsokat láthatunk

A nagy intenzitású molekula pályáknak megfelelő csúcsok mellett ekvidisztáns távolságra lévő szatelit csúcsok jelennek meg

Rendszer állapotát 2 kvantumszámmal írjuk le:

Elektromos energia szintek LUMO, LUMO+1, ... → 1, 2, ... Molekula rezgés gerjesztése 0, 1, 2, ... LUMO energia plusz 180meV és 2x180meV C-C rezgés gerjesztési csúcsai



Számolás: szaggatott vonalak e-vibron csatolás nélküli energia állapotok, teli vonalak e-vibr. csatolás

Ábrázolás a legalacsonyabb állapot (1,0)-hoz képesti energia különbség а Length (thiophene units) 19 10 7 2,1 |3, 0) 0.6 Ha e-vibr. csatolás létezik, adott hossznál (1,1) és (2,0) 0.4 ΔE (eV) állapotok |1, 2> energiája azonos Avoideo \rightarrow anti-crossing 0.2 crossing |1, 1> $|1, 1\rangle \pm |2, 0\rangle$ 1, 0 0 0.10 0.04 0.06 0.08 $\pi/\text{length}(\text{Å}^{-1})$



A mérésekben is megjelenik az anti-crossing

Ez azt mutatja, hogy az elektronok és a molekula rezgés csatolódik ún. nem-Born-Oppenheimer tartomány érhető el hosszú molekulákra

Anti-crossing: Ahol két állapot energiája megegyezik, pl. (1,1) és (2,0) amikor a vibrációs energia és az elektromos energiaszint megegyezik

$$H = \begin{pmatrix} \varepsilon & \gamma \\ \gamma & \varepsilon \end{pmatrix}. \quad \longrightarrow \quad (|1,1\rangle \pm |2,0\rangle)/\sqrt{2}$$

Szemiklasszikus kép: elektromechanikai oszcillátor, tehát az elektronok a molekula frekvenciájával oszcillálnak a molekula bal és jobb oldala közt.

Kvantumosan:

Elektron állapotok

Vibron állapotok

$$|r\rangle_e := 1/\sqrt{2}(|1\rangle_e - |2\rangle_e),$$

$$l\rangle_e := 1/\sqrt{2}(|1\rangle_e + |2\rangle_e).$$

$$|r\rangle_{\mathrm{v}} := 1/\sqrt{2}(|0\rangle_{\mathrm{v}} + |1\rangle_{\mathrm{v}}),$$

$$|l\rangle_{\nu} := 1/\sqrt{2}(|0\rangle_{\nu} - |1\rangle_{\nu}).$$

harmonic oscillator





$$(|1,1\rangle - |2,0\rangle)/\sqrt{2} = (+|r,r\rangle - |l,l\rangle)/\sqrt{2},$$
$$(|1,1\rangle + |2,0\rangle)/\sqrt{2} = (-|r,l\rangle + |l,r\rangle)/\sqrt{2}.$$



Imaging the charge distribution within a single molecule

Fabian Mohn*, Leo Gross, Nikolaj Moll and Gerhard Meyer

Naphthalocyanine molekulán belüli töltéseloszlás vizsgálata

STM/AFM/KPFM mérések



а

IFTTFRS



nature nanotechnology



0.175nm

CO végződésű tű (eddig ilyen nem volt KPFM-ben)

Ilyenkor erős magasság függés

0.22-0.19nm az STM setpoint fölött

h.

Itt is jelentős

felbontás javulás

0.19nm sűrűbb grid-el Asszimetria a substrate háttér vagy a tű miatt Mivel a kapcsolás során

nem változott









<u>Konklúzió:</u>

STM-es mérések fontos és speciális lehetőségeket nyújtanak a molekuláris elektronika témakörében végzett kutatásokban

A mérések szempontjából a molekula és a substrate illetve szigetelő réteg csatolódása miatt fontos azok megfelelő megválasztása Jelentős változást okozhat a ■ molekulák tul. pl.: kapcsolható molekulák nem kapcsolhatók lesznek, ill fordítva

Az STM tű hegye (anyag kombinációja) szintén sok újszerű és különböző lehetőségeket tartogató kísérletet tartogat

Láthattuk, hogy az eszközök tervezésénél (switch, vezeték) esetekben a korábban használt egyszerű modellek helyett új jelenségeket is figyelembe kell vennünk

Köszönöm a figyelmet!

Tű és minta hfv-ének átlapolása a gap közepén található szeparációs felületen

$$I = \frac{2\pi e}{\hbar} \sum_{\mu,\nu} f(E_{\mu}) [1 - f(E_{\nu} + eV)] |M_{\mu\nu}|^{2} \delta(E_{\mu} - E_{\nu})$$

$$M = \frac{\hbar^{2}}{2m_{e}} \int_{\Sigma} (\chi^{*} \nabla \psi - \psi \nabla \chi^{*}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$(\nabla^{2} - \kappa^{2}) \chi(\mathbf{r}) = 0 \qquad (\nabla^{2} - \kappa^{2}) G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0}) = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0})$$

$$G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0}) = \frac{\kappa}{2} k_{0}(\kappa \rho) \qquad \chi_{1}(\mathbf{r}) = \frac{4\pi C}{2} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0})$$

Bessel fv azonosságok

 4π

$$\chi_{s}(\mathbf{r}) = \frac{4\pi C}{\kappa} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0})$$
$$\chi_{p_{z}}(\mathbf{r}) = \frac{4\pi C}{\kappa} \frac{\partial}{\kappa \partial z_{0}} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0})$$
$$\chi_{p_{x}}(\mathbf{r}) = \frac{4\pi C}{\kappa} \frac{\partial}{\kappa \partial x_{0}} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0})$$

$$\chi_{p_y}(\mathbf{r}) = \frac{4\pi C}{\kappa} \frac{\partial}{\kappa \partial y_0} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

х,



$$M_{s} = \frac{2\pi C\hbar^{2}}{\kappa m_{e}} \int_{\Omega_{T}} [G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0})\nabla^{2}\psi - \psi\nabla^{2}G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0})]d\tau$$

$$M_{s} = \frac{2\pi C\hbar^{2}}{\kappa m_{e}}\psi(\mathbf{r}_{0}) \qquad \longrightarrow \quad \frac{2\pi C\hbar^{2}}{\kappa m_{0}}\frac{\partial\psi(\mathbf{r}_{0})}{\partial z_{0}} = \frac{\hbar^{2}}{2m_{e}}\int_{\Sigma}[\chi_{p_{z}}(\mathbf{r})\nabla\psi - \psi\nabla\chi_{p_{z}}(\mathbf{r})]\cdot d\mathbf{S}$$

deriváltja

Kelvin Probe Force Microscopy

A minta és a tű kilépési munkájának különbsége az ún. kontakt potenciál

V_{CPD}

Egy DC és egy AC feszt bekapcsolva: $V = (V_{DC} - V_{CPD}) + V_{AC} \sin(\omega t)$

A tű és a minta közti erő:

$$F = \frac{1}{2} \frac{\partial C}{\partial z} V^2$$

Beírva a feszültséget:

$$F_{DC} \propto \frac{1}{2} (V_{DC} - V_{CPD})^2 + \frac{1}{4} V_{AC}^2$$

$$F_{\omega} \propto (V_{DC} - V_{CPD}) V_{AC} \sin(\omega t)$$

